

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по учебной работе

Дата подписания: 27.10.2023 15:15:02

Уникальный идентификатор документа:

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Электроника

Закреплена за подразделением

Кафедра ППЭ и ФПП

Направление подготовки

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ

Профиль

Квалификация

Инженер-исследователь

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану

108

Формы контроля в семестрах:

в том числе:

зачет с оценкой 5

аудиторные занятия

51

самостоятельная работа

57

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	5 (3.1)		Итого	
	Неделя 19			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	17	17	17	17
Лабораторные	17	17	17	17
Практические	17	17	17	17
Итого ауд.	51	51	51	51
Контактная работа	51	51	51	51
Сам. работа	57	57	57	57
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):
к.т.н., доц., Орлова М.Н.

Рабочая программа
Электроника

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» по направлению подготовки 22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ (приказ от 28.06.2023 г. № 292 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ, 22.03.01-БМТМ-23_6-ПП.plx , утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.06.2023, протокол № 5-23

Утверждена в составе ОПОП ВО:

22.03.01 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ, , утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.06.2023, протокол № 5-23

Рабочая программа одобрена на заседании
Кафедра ППЭ и ФПП

Протокол от 21.06.2023 г., №11

Руководитель подразделения Диденко Сергей Иванович, к.ф.-м.н., доцент

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1	Целью освоения дисциплины является формирование у студентов компетенций в соответствии с учебным планом, применительно к изучению и формированию знаний в области полупроводниковых электронных компонентов, принципов их функционирования и измерению электрических параметров с использованием контрольно-измерительных приборов.
-----	---

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП:		Б1.В.ДВ.02
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Введение в квантовую механику	
2.1.2	Кристаллография	
2.1.3	Математическая статистика и анализ данных	
2.1.4	Методы математической физики	
2.1.5	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений	
2.1.6	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений	
2.1.7	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений	
2.1.8	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений	
2.1.9	Физика	
2.1.10	Физическая химия	
2.1.11	Электротехника	
2.1.12	Математика	
2.1.13	Органическая химия	
2.1.14	Химия	
2.1.15	Аналитическая геометрия	
2.1.16	Инженерная и компьютерная графика	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Диффузия и диффузионно-контролируемые процессы	
2.2.2	Защита интеллектуальной собственности и патентование	
2.2.3	Коррозия и защита металлов	
2.2.4	Метрология и стандартизация цифровых технологий в материаловедении и металлургии	
2.2.5	Метрология и технические измерения функциональных материалов	
2.2.6	Метрология, стандартизация и технические измерения	
2.2.7	Метрология, стандартизация и технические измерения в электронике	
2.2.8	Разработка новых материалов	
2.2.9	Физика диэлектриков	
2.2.10	Физика металлов	
2.2.11	Атомное строение фаз	
2.2.12	Биохимия наноматериалов	
2.2.13	Инженерия поверхности	
2.2.14	Металловедение и термическая обработка металлов	
2.2.15	Методы исследования структур и материалов. Часть 1	
2.2.16	Методы исследования физических свойств полупроводниковых структур	
2.2.17	Наноматериалы	
2.2.18	Научно-исследовательская работа	
2.2.19	Научно-исследовательская работа	
2.2.20	Научно-исследовательская работа	
2.2.21	Научно-исследовательская работа	
2.2.22	Сверхтвердые материалы	
2.2.23	Технологии материалов с особыми физическими свойствами	
2.2.24	Фазовые и структурные изменения при формировании материалов и эпитаксиальных структур	
2.2.25	Физика магнитных явлений	
2.2.26	Физика полупроводниковых приборов	

2.2.27	Физика прочности
2.2.28	Физика прочности и механические свойства материалов
2.2.29	Физико-химия металлов и неметаллических материалов
2.2.30	Физические основы деформации и разрушения
2.2.31	Атомная и электронная структура поверхности и межфазных границ
2.2.32	Композиционные материалы
2.2.33	Конструирование композиционных материалов
2.2.34	Методы исследования структур и материалов. Часть 2
2.2.35	Поверхностное модифицирование материалов и защитные покрытия
2.2.36	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.37	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.38	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.39	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.40	Специальные сплавы
2.2.41	Физическое материаловедение сплавов с особыми магнитными свойствами, часть 1. Магнитно-мягкие сплавы
2.2.42	Физическое материаловедение сплавов с особыми магнитными свойствами, часть 2. Магнитно-твердые сплавы
2.2.43	Аморфные, микро- и нанокристаллические материалы
2.2.44	Биофизика
2.2.45	Высокотемпературные и сверхтвердые функциональные и конструкционные материалы
2.2.46	Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве
2.2.47	Материаловедение и технологии перспективных материалов
2.2.48	Методы исследования характеристик и свойств материалов
2.2.49	Методы электронной микроскопии для материалов твердотельной электроники
2.2.50	Метрология и испытания функциональных материалов
2.2.51	Основы научно-технического перевода
2.2.52	Практика научно-технического перевода и редактирования
2.2.53	Тензорные методы в кристаллофизике
2.2.54	Технология получения кристаллов
2.2.55	Физические основы магнетизма и процессы перемангничивания материалов
2.2.56	Физические свойства приповерхностных слоев и методы их исследований
2.2.57	Функциональные наноматериалы
2.2.58	Химия и технология полимерных материалов
2.2.59	Биоорганическая химия
2.2.60	Высокотемпературные керамические материалы
2.2.61	Жаропрочные и радиационно-стойкие материалы
2.2.62	Квантовая теория твердого тела
2.2.63	Математическое и компьютерное моделирование материалов и процессов электроники
2.2.64	Методы исследования макро- и микроструктуры материалов
2.2.65	Методы непараметрической статистики
2.2.66	Некоторые главы кристаллохимии
2.2.67	Объемные наноматериалы
2.2.68	Процессы получения и обработки сверхтвердых материалов
2.2.69	Структура и технологичность сплавов
2.2.70	Физико-химия эволюции твердого вещества
2.2.71	Ядерно-спектроскопические и синхротронные методы исследований
2.2.72	Аттестация и испытания высокотемпературных и сверхтвердых материалов
2.2.73	Аттестация и сертификация изделий электронной техники
2.2.74	Компьютерные и информационные технологии в науке и производстве функциональных материалов
2.2.75	Материаловедение и технологии перспективных материалов
2.2.76	Материалы и элементы спинтроники и спинволновой оптики
2.2.77	Менеджмент качества
2.2.78	Металлические материалы для крупных транспортных систем
2.2.79	Металловедение высокопрочных сплавов

2.2.80	Методология и практика определения размерных характеристик материалов
2.2.81	Методология научных исследований
2.2.82	Оптические явления в кристаллах. Часть 2
2.2.83	Основы клеточной биологии
2.2.84	Оформление результатов научной деятельности
2.2.85	Практическое применение теории функционала электронной плотности
2.2.86	Симметрия наносистем
2.2.87	Современные компьютерные технологии в структурном анализе
2.2.88	Спектроскопические и зондовые методы
2.2.89	Термомеханическая обработка металлов и сплавов
2.2.90	Управление коллективами
2.2.91	Управление проектами
2.2.92	Химические основы биологических процессов
2.2.93	Цифровое материаловедение
2.2.94	Нормы и правила оформления ВКР
2.2.95	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.96	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.97	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.98	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.99	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.100	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.101	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.102	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям

Знать:

ПК-1-31 Электронную компонентную базу изделий электронной техники и микросборок

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя знания фундаментальных наук, методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания

Знать:

ОПК-1-31 Основные законы физики, математики и естественных наук

ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям

Уметь:

ПК-1-У1 Осуществлять обработку и анализ научно-технической информации и результатов исследований

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя знания фундаментальных наук, методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания

Уметь:

ОПК-1-У1 Проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных

ПК-1: Способен к поиску новых направлений научных исследований и синтезу знаний в области материаловедения и технологии материалов, способен оформлять технические задания и отчетные материалы по планируемым и проведенным исследованиям

Владеть:

ПК-1-В1 Методами сбора данных, изучения, анализа и обобщения научно-технической информации

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности, применяя знания фундаментальных наук, методы моделирования, математического анализа, естественнонаучные и общинженерные знания

Владеть:

ОПК-1-В1 Методами моделирования и математического анализа для решения типовых задач

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполняемые работы
	Раздел 1. Физические основы электронных приборов							
1.1	Основные этапы развития электроники. Текущий технический уровень электроники и перспективы ее развития /Лек/	5	2	ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			
1.2	Полупроводниковые материалы применяемые в электроники /Лек/	5	2	ОПК-1-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			
1.3	Физические процессы в р-п (электронно-дырочном) переходе /Пр/	5	4	ОПК-1-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3	Решение типовых задач		
1.4	Основы зонной теории в полупроводниках /Лек/	5	3	ОПК-1-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			
1.5	Проработка учебно-методического материала для подготовки к контрольной работе /Ср/	5	4	ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			Р7
1.6	Проработка учебно-методического материала для подготовки к практическим занятиям /Ср/	5	3	ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.2 Э1 Э3			
1.7	Проработка учебно-методического материала для выполнения домашней работы /Ср/	5	4	ОПК-1-31 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л2.3Л2.1 Л2.2 Л2.4Л3.2 Э1 Э3	LMS Canvas		Р3
	Раздел 2. Элементная база электроники							
2.1	Полупроводниковые диоды (выпрямительные) /Лек/	5	3	ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			

2.2	Транзисторы (биполярные, полевые) в электронных схемах /Лек/	5	3	ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			
2.3	Пассивные элементы приборов электроники (конденсаторы, резисторы) /Пр/	5	4	ОПК-1-В1 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3	Решение типовых задач и составление схем с пассивными элементами		
2.4	Контрольная работа 1. /Пр/	5	2	ОПК-1-31 ПК-1-31 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э3		КМ1	Р7
2.5	Контрольная работа 2. /Пр/	5	2	ПК-1-31 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э3		КМ2	Р8
2.6	Лабораторная работа 1. Изучение работы Диода (определение работоспособности диодов и определение их полярности). /Лаб/	5	5	ОПК-1-У1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э2	Лабораторная станция NI ELVIS2+	КМ6	Р1
2.7	Лабораторная работа 2. Изучение работы Транзисторного каскада с общим эмиттером, с общим истоком. /Лаб/	5	6	ОПК-1-У1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э2	Лабораторная станция NI ELVIS2+	КМ7	Р2
2.8	Проработка учебно-методического материала для выполнения домашней работы /Ср/	5	10	ОПК-1-31 ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			
2.9	Тест 1. /Ср/	5	2	ОПК-1-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э3		КМ3	Р4
2.10	Тест 2. /Ср/	5	2	ОПК-1-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э3		КМ4	Р5
2.11	Проработка учебно-методического материала для подготовки к контрольной работе /Ср/	5	4	ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			Р8

2.12	Проработка учебно-методического материала для подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям /Ср/	5	6	ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э2 Э3			
	Раздел 3. Схемы электронных устройств							
3.1	Однофазные полупроводниковые выпрямители. Транзисторный каскад в схеме с общим эмиттером и общим истоком /Лек/	5	4	ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			
3.2	Методика схемотехнического проектирования элементов электроники /Пр/	5	5	ПК-1-31 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3	Составление типовых схем с применением пакетов прикладных программ		
3.3	Лабораторная работа 3. Проектирование схемы усиления постоянного тока с помощью биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером /Лаб/	5	6	ОПК-1-У1 ПК-1-31 ПК-1-У1 ПК-1-В1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э2	Лабораторная станция NI ELVIS2+	КМ8	Р9
3.4	Проработка учебно-методического материала для выполнения домашней работы /Ср/	5	12	ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э3			
3.5	Тест 3. /Ср/	5	2	ОПК-1-31 ПК-1-31	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Л3.2 Э3		КМ2	Р6
3.6	Проработка учебно-методического материала для подготовки к лабораторной работе и практическим занятиям /Ср/	5	8	ПК-1-31 ПК-1-У1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5Л3.1 Э1 Э2 Э3			

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки

Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки
КМ1	Контрольная работа 1.	ОПК-1-31	1. Классификация диодов. 2. Вольт-амперная характеристика р-п (электронно-дырочного) идеального и реального перехода. 3. Параметров диодов схемах. 4. Режимы работы диодов. 5. Однофазная схема мостового выпрямителя (рисунок, элементы, электрофизические характеристики).

КМ2	Контрольная работа 2.	ОПК-1-31	<ol style="list-style-type: none"> 1. Классификация транзисторов. 2. Режимы работы транзисторов (биполярных, полевых). 3. Расчет параметров усилительных схем с транзисторами. 4. Диодное включение транзисторов с схемах. 5. Схемы включения транзисторов.
КМ3	Тест 1.	ОПК-1-31	<p>Примерный вариант задания</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Полупроводниковый диод: <ol style="list-style-type: none"> А) имеет два р-п – перехода Б) имеет один р-п – переход В) не имеет р-п – переход 2. Прямой ток - ... <ol style="list-style-type: none"> А) ток протекающий через диод, при подключении его р-области к «+», а п-области к «-» источника тока Б) ток протекающий через диод, при подключении его р-области к «-», а п-области к «+» источника тока 3. Почему диод не пропускает ток в обоих направлениях? <ol style="list-style-type: none"> А) при обратном включении между двумя областями возникает область, которая не имеет свободных носителей электрического тока Б) при обратном включении источник тока не работает В) диод нельзя включать в обратном направлении 4. Пробой диода наступает при: <ol style="list-style-type: none"> А) превышении прямого тока Б) достижении обратным напряжением некоторого критического значения В) отсутствии тока 5. Полупроводниковый диод служит для: <ol style="list-style-type: none"> А) увеличения напряжения или тока Б) преобразования переменного тока в постоянный В) управления внешними устройствами
КМ4	Тест 2.	ОПК-1-31	<p>Примерный вариант задания</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Полупроводниковый транзистор – это ... <ol style="list-style-type: none"> А) два встречно включенных диода Б) электронный прибор, имеющий два р-п – перехода В) полупроводниковый нагревательный элемент 2. Транзистор имеет структуру: <ol style="list-style-type: none"> А) р-р-п Б) р-п-р В) п-п-р 3. Центральная область транзистора - ... <ol style="list-style-type: none"> А) коллектор Б) эмиттер В) база 4. Кроме транзисторов бывают ... <ol style="list-style-type: none"> А) биполярные транзисторы Б) полевые транзисторы В) литиевые транзисторы 5. Транзистор считается закрытым при: <ol style="list-style-type: none"> А) наличии напряжения на базе Б) наличии напряжения на эмиттере В) отсутствии напряжения на базе

КМ5	Тест 3.	ОПК-1-31	<p>Примерный вариант задания</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Емкость конденсатора измеряют <ol style="list-style-type: none"> А) фарадах Б) амперах В) омах 2. Что называется конденсатором <ol style="list-style-type: none"> А) двухполюсник с постоянным или переменным значением ёмкости и малой проводимостью Б) обратно смещенный р-п переход В) устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 3. По материалу диэлектрика различают <ol style="list-style-type: none"> А) три вида конденсаторов: с твердым, газообразным и жидким диэлектриком Б) два вида конденсаторов: с твердым и жидким диэлектриком В) три вида конденсаторов: с газообразным и жидким диэлектриком 4. Как измениться энергия электрического поля конденсатора, если напряжение на его обкладках увеличить в 2 раза <ol style="list-style-type: none"> А) увеличится в 2 раза Б) уменьшится в 2 раза В) увеличится в 4 раза 5. От каких факторов зависит электрическая емкость конденсатора <ol style="list-style-type: none"> А) от площади обкладок, расстояния между ними и диэлектрика Б) от площади обкладок и материала из которых они изготовлены В) от расстояния между обкладками
КМ6	Лабораторная работа 1. Изучение работы Диода (определение работоспособности диодов и определение их полярности).	ОПК-1-31;ОПК-1-У1	<p>Примерный перечень вопросов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Какой электронный прибор называется полупроводниковый диод? 2. Сформулируйте классификацию основных типов полупроводниковых диодов, характеристики и области применения каждого из них. 3. На какие группы можно разделить диоды? 4. В чем заключается работа выпрямительных диодов в схемах? 5. На какие группы делятся выпрямительные диоды в зависимости от частоты ? 6. Из каких материалов изготавливаются выпрямительные полупроводниковые диоды ? 7. На какие группы делятся выпрямительные диоды в зависимости от конструкции ? 8. Сравните токи через диод в прямом и обратном смещении. Объясните различия. 9. Поясните работу диода при прямом и обратном включении. 10. Как называются выводы диода и каковы их полярности? 11. Что показывает вольт-амперная характеристика диода? 12. Дифференциальное сопротивление. (формула) 13. Как строятся вольт-амперные характеристики идеального и реального диодов? 14. Условное обозначение диода. (начертить) 15. Структура диода. (начертить). 16. Что такое пробой диода, виды пробоя? Какие виды пробоя диодов бывают? 17. Что такое однополупериодный выпрямитель? 18. Как изменяется ветвь обратной вольт-амперной характеристики диода при росте температуры? 19. Какие основные параметры диода следует учитывать при проектировании электрических схем? 20. Почему диод не пропускает ток в обоих направлениях?

КМ7	Лабораторная работа 2. Изучение работы Транзисторного каскада с общим эмиттером, с общим истоком.	ОПК-1-31;ОПК-1-У1	<p>Примерный перечень вопросов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Что такое «биполярный транзистор»? 2. Дайте классификацию биполярных транзисторов. 3. Изобразите конструкцию биполярно транзистора, схему и условное обозначение. 4. Объясните принцип действия биполярного транзистора. 5. Перечислите схемы включения биполярного транзистора. 6. Назовите режимы работы биполярного транзистора и области их применения. 7. Нарисуйте входные характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером и поясните их. 8. Нарисуйте выходные характеристики биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером и поясните их. 9. Запишите уравнение, связывающее ток коллектора с током базы в нормальном активном режиме. 10. Нарисуйте схему для исследования характеристик и параметров биполярного транзистора. Поясните назначение элементов схемы. 11. Что такое «полевой транзистор»? 12. Дайте классификацию полевых транзисторов. 13. Изобразите конструкцию полевого транзистора, схему и условное обозначение. 14. Назовите основные статические характеристики полевого транзистора и дайте их определения. 15. Изобразите выходные статические характеристики полевого транзистора с управляющим р-п-переходом и объясните их. 16. Изобразите передаточные статические характеристики полевого транзистора с управляющим р-п-переходом и объясните их. 17. Перечислите схемы включения полевого транзистора. 18. Почему схема с общим затвором не используется на практике? 19. Нарисуйте схему для исследования полевого транзистора и объясните назначение ее элементов. 20. Поясните влияние температуры на передаточную характеристику полевого транзистора с управляющим р-п-переходом.
КМ8	Лабораторная работа 3. Проектирование схемы усиления постоянного тока с помощью биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером	ОПК-1-31;ОПК-1-У1;ОПК-1-В1	<p>Примерный перечень вопросов</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Схемы включения биполярных транзисторов? 2. Способы задания режима работы по постоянному току в транзисторном каскаде с общим эмиттером? 3. Алгоритм построения нагрузочной линии на семействе выходных характеристик биполярного транзистора? 4. От каких параметров зависит коэффициент усиления транзисторного каскада с общим эмиттером? 5. При каком условии биполярный транзистор будет находится в режиме отсечки? 6. При каком условии биполярный транзистор будет находится в активном режиме? 7. При каком условии биполярный транзистор будет находится в режиме насыщения? 8. Как включить дополнительные элементы по схеме с общим эмиттером (начертить схему)? 9. Поясните назначение резисторов и конденсаторов в схеме усилителя постоянного тока? 10. Изобразите протекание тока по входным цепям схемы с общим эмиттером (начертить)? 11. Эквивалентная схема входной цепи схемы с общим эмиттером, поясните принцип работы по току? 12. Для чего необходим постоянный ток в схеме включения биполярного транзистора с общим эмиттером? 13. Перечислите параметры усилительных схем с транзисторами? 14. Поясните условие перехода работы биполярных транзисторов в состояние насыщения, по схеме с общим эмиттером? 15. Как измениться величина и форма импульса на выходе схемы усилительного каскада с общим эмиттером при изменении сопротивления на коллекторе биполярного транзистора?

5.2. Перечень работ, выполняемых по дисциплине (Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)			
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы
P1	Лабораторная работа 1.	ОПК-1-31;ОПК-1-У1	Изучение работы Диода (определение работоспособности диодов и определение их полярности).
P2	Лабораторная работа 2.	ОПК-1-31;ОПК-1-У1	Изучение работы Транзисторного каскада с общим эмиттером, с общим истоком.
P3	Домашняя работа	ОПК-1-31;ОПК-1-В1	Элементная база электроники (полупроводниковые диоды, транзисторы (биполярные, полевые), конденсаторы, резисторы, стабилитроны, тиристоры). Разработка технического описания на отдельные блоки изделий электронной техники.
P4	Тест 1.	ОПК-1-31	Полупроводниковые диоды.
P5	Тест 2.	ОПК-1-31	Транзисторы (биполярные, полевые).
P6	Тест 3.	ОПК-1-31	Конденсаторы в отдельных блоки изделий электронной техники.
P7	Контрольная работа 1.	ОПК-1-31;ОПК-1-В1	Расчет параметров диодов в электрических схемах.
P8	Контрольная работа 2.	ОПК-1-31;ОПК-1-В1	Расчет параметров транзисторов в электрических схемах.
P9	Лабораторная работа 3.	ОПК-1-31;ОПК-1-У1;ОПК-1-В1	Проектирование схемы усиления постоянного тока с помощью биполярного транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером
5.3. Оценочные материалы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)			
Экзамен по дисциплине не предусмотрен			

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

По дисциплине для получения зачета с оценкой студент должен выполнить: контрольные работы, лабораторные работы, тесты и домашние задания. По итогу всех контрольно-тестовых мероприятий, выставляется средняя арифметическая оценка: округление менее 2,60 - неудовлетворительно; 2,61 - удовлетворительно; 3,61 - хорошо; 4,61 - отлично.

Оценки за контрольную работу выставляются по следующим критериям:

- а) «отлично» – студент правильно решил задачи и полно ответил на все теоретические вопросы;
- б) «хорошо» – студент решил задачи и недостаточно полно ответил на все теоретические вопросы;
- в) «удовлетворительно» – студент неправильно решил задачи, неполно ответил на теоретические вопросы;
- г) «неудовлетворительно» – студент не решил задачу, не ответил на теоретические вопросы.

Оценки за тесты выставляются по следующим критериям:

- 0% - не выполнено;
- 1%-40% - неудовлетворительно;
- 41%-65% - удовлетворительно;
- 66%-85% - хорошо;
- 86%-100% - отлично.

Оценка за домашнюю работу выставляется по следующим критериям:

- а) «отлично» – студент правильно провел необходимые расчеты, представил графики зависимостей, сделал правильные выводы, исчерпывающе ответил на вопросы при защите работы;
- б) «хорошо» – студент правильно или с небольшими ошибками провел необходимые расчеты, представил графики зависимостей, сделал правильные выводы, недостаточно полно ответил на вопросы при защите работы;;
- в) «удовлетворительно» – студент провел необходимые расчеты с незначительными ошибками, представил неверные графики зависимостей, сделал неполные или неправильные выводы, недостаточно полно ответил на вопросы при защите работы;
- г) «неудовлетворительно» – студент провел необходимые расчеты с грубыми ошибками, представил неверные графики зависимостей, сделал неправильные выводы, не ответил или ответил неверно на вопросы при защите работы.

Оценка зачет за лабораторные работы выставляется по итогу выполнения, если студент выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все эксперименты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.1	Кузовкин В. А.	Электроника. Электрофизические основы, микросхемотехника, приборы и устройства: учебник	Электронная библиотека	Москва: Логос, 2011
Л1.2	Земляков В. Л.	Электротехника и электроника: учебник	Электронная библиотека	Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2008
Л1.3	Федоров С. В., Бондарев А. В.	Электроника: учебник	Электронная библиотека	Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2015
Л1.4	Барыбин А. А.	Электроника и микроэлектроника. Физико-технологические основы: учебное пособие	Электронная библиотека	Москва: Физматлит, 2008

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Троян П. Е.	Микроэлектроника: учебное пособие	Электронная библиотека	Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007
Л2.2	Легостаев Н. С., Четвергов К. В.	Микроэлектроника: учебное пособие	Электронная библиотека	Томск: Эль Контент, 2013

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.3	Дмитриев В. М., Шутенков А. В., Хатников В. И., Ганджа Т. В., Шандарова Е. Б.	Теоретические основы электротехники: учебное пособие	Электронная библиотека	Томск: ТУСУ, 2015
Л2.4	Петренко Ю. В.	Теоретические основы электротехники: электрические цепи с распределенными параметрами: учебное пособие	Электронная библиотека	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019
Л2.5	Крутов А. В., Кочетова Э. Л., Гузанова Т. Ф.	Теоретические основы электротехники: учебное пособие	Электронная библиотека	Минск: РИПО, 2016

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Легостаев Н. С., Четвергов К. В.	Твердотельная электроника: учебное пособие	Электронная библиотека	Томск: Эль Контент, 2011
Л3.2	Мухтаров А. Ш., Соколов Ю. Г., Толмачева А. В., Хайруллин И. Р.	Подготовка к интернет-тестированию по дисциплине «Электротехника и электроника»: учебно-методическое пособие	Электронная библиотека	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Э1	Научно-техническая библиотека НИТУ "МИСиС"	http://elibrary.misis.ru/
Э2	Circuit Design Suite объединяет программное обеспечение Multisim и Ultiboard, чтобы предложить полный набор средств для проектирования, симуляции, валидации и компоновки схем	https://www.ni.com/ru-ru/support/downloads/software-products/download.circuit-design-suite.html#305920
Э3	LMS Canvas Курс "Электроника"	https://lms.misis.ru/

6.3 Перечень программного обеспечения

П.1	LMS Canvas
П.2	MS Teams

6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных

И.1	Научные журналы и статьи
И.2	http://elibrary.ru/
И.3	https://link.springer.com/
И.4	Web of Science https://apps.webofknowledge.com
И.5	Scopus https://www.scopus.com/
И.6	Elsevier https://www.sciencedirect.com/
И.7	Курс "Наноэлектроника" на платформе LMS Canvas
И.8	https://lms.misis.ru
И.9	Электронная библиотека МИСиС
И.10	http://elibrary.misis.ru/
И.11	Электронная библиотека издательство "Лань"
И.12	https://e.lanbook.co
И.13	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
И.14	https://window.edu.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ауд.	Назначение	Оснащение
------	------------	-----------

Любой корпус Мультимедийная	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и/или для проведения практических занятий:	комплект учебной мебели до 36 мест для обучающихся, мультимедийное оборудование, магнитно-маркерная доска, рабочее место преподавателя, ПКс доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus
К-504	Лаборатория	характериограф TR-4805; вольтметр В7-138; компьютеры с ПО для проведения лабораторных работ (4 шт.); междисциплинарная лабораторная платформа с комплектом ПО NI ELVIS II+; плата "Аналоговая электроника"(4 шт.); ПК; комплект учебной мебели
Читальный зал электронных ресурсов		комплект учебной мебели на 55 мест для обучающихся, 50 ПК с доступом к ИТС «Интернет», ЭИОС университета через личный кабинет на платформе LMS Canvas, лицензионные программы MS Office, MS Teams, ESET Antivirus.
Любой корпус Компьютерный класс	Учебная аудитория для проведения практических занятий:	экран, проектор, доска, комплект учебной мебели на 30 посадочных мест, персональные компьютеры, доступ к ЭИОС университета LMS Canvas, лицензионные программы MS Teams, MS Office

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина относится к точным наукам и требует значительного объема самостоятельной работы. Отдельные учебные вопросы выносятся на самостоятельную проработку и контролируются посредством текущей аттестации. При этом организуются групповые и индивидуальные консультации. Расчетно-графические работы выполняются с помощью пакета прикладных программ.

Образовательная деятельность по дисциплине реализуется с помощью электронной информационно-образовательной среды НИТУ «МИСиС» Canvas, представленной на сайте <https://lms.misis.ru/>. В учебном процессе используются программные базы вуза и автоматизированные средства взаимодействия преподавателя и обучающегося. Электронный контент в Canvas содержит все календарные события курса, навигационные ссылки, тесты, задания, методические рекомендации и электронные материалы.